

01

Эллипсоидальное включение с оболочкой в анизотропной среде с однородным приложенным электрическим полем

© И.В. Лавров, В.Б. Яковлев

Национальный исследовательский университет Московский институт электронной техники,
124498 Москва, Зеленоград, Россия
e-mail: iglavr@mail.ru

(Поступило в Редакцию 16 ноября 2017 г.)

Получено решение электростатической задачи для диэлектрического включения, состоящего из анизотропных ядра и оболочки, помещенного в однородную анизотропную диэлектрическую среду (матрицу) с приложенным однородным электрическим полем. Внешние границы ядра и оболочки считаются эллипсоидами, являющимися софокусными после линейного неортогонального преобразования, устраняющего анизотропию диэлектрических свойств оболочки. Найдены аналитические выражения для потенциала и напряженности электрического поля в матрице, оболочке и ядре, а также выражение для тензора поляризуемости включения. Рассмотрен специальный случай включения с изотропной оболочкой. Полученные выражения применены для случая анизотропного шара с изотропной оболочкой в анизотропной среде. Также показано, что в предельном случае однородного эллипсоидального включения в анизотропной среде полученный результат согласуется с известными решениями.

DOI: 10.21883/JTF.2018.10.46490.2565

Введение

Необходимость в вычислении распределения электрического поля внутри и снаружи включения, погруженного в анизотропную среду, возникает при прогнозировании макроскопических свойств неоднородных текстурированных материалов, т.е. материалов, обладающих анизотропией эффективных характеристик. В частности, при применении метода самосогласованного решения [1,2], называемого также методом эффективной среды, идея которого принадлежит Бруггеману [3], реальная неоднородная среда, окружающая включение, заменяется на однородную с эффективными материальными свойствами.

Вариант обобщения метода эффективной среды на материалы с неоднородными включениями предложен в [4]; для его применения в анизотропном случае требуется знание распределения электрического поля внутри так называемого „эффективного рассеивателя“, погруженного в эффективную анизотропную среду. В работе [5] предложено обобщенное приближение эффективного поля для вычисления макроскопических характеристик неоднородных сред, содержащих неоднородные включения, состоящие из однородного ядра и однородной оболочки, внешние границы которых считаются эллипсоидальными. Для его применения требуется знание связи между средними значениями напряженности поля в ядре и оболочке изолированного включения, погруженного в однородную, возможно, анизотропную среду, и эффективным полем в данной среде.

Настоящая работа является продолжением [6], и ее результаты естественным образом обобщают результаты работы [6] на случай эллипсоидального включения с оболочкой, помещенного в бесконечную анизотропную

среду (матрицу) с однородным приложенным электрическим полем. Внешние границы ядра и оболочки включения считаются эллипсоидальными, становящимися софокусными после линейного преобразования, устраняющего анизотропию материальных свойств оболочки. На первый взгляд, это условие является искусственным и не имеющим отношение к реальным ситуациям, однако в реальных неоднородных средах даже эллипсоидальная форма включений в точности практически никогда не встречается, а является модельным приближением для частиц неизометричной формы. По мнению авторов, введение дополнительной связи между формами ядра и оболочки и тензором материального свойства оболочки оправдано, поскольку позволяет получить компактное аналитическое выражение для решения задачи.

В настоящей работе исходная задача для включения в анизотропной среде решается путем сведения ее посредством линейного неортогонального преобразования к задаче для включения с оболочкой в вакууме, решение которой известно [6]. Затем с помощью обратного преобразования из решения задачи в вакууме получается решение исходной задачи в анизотропной среде. Получено также выражение для тензора поляризуемости включения. Рассмотрен частный случай включения с изотропной оболочкой, а также примеры применения полученных результатов для сферического включения с изотропной оболочкой в анизотропной, а затем в изотропной среде. Также рассмотрен предельный случай эллипсоидального однородного включения в анизотропной среде; показано, что результаты в этом случае совпадают с известными [7,8].

Сделаем замечание, касающееся используемых в работе терминов. В математике термин „эллипсоид“ обозначает замкнутую поверхность 2-го порядка, а специаль-

ного термина, обозначающего тело, ограниченное этой поверхностью, нет. Между тем в физической литературе как в классических трудах [9–11], так и в ряде относительно новых работ [8,12–14] термин „эллипсоид“ используется для обозначения объемного тела, ограниченного поверхностью 2-го порядка — эллипсоидом. В настоящей работе в согласии с терминологией, принятой в физической литературе, термин „эллипсоид“ будет использоваться для обозначения тела, ограниченного замкнутой поверхностью 2-го порядка, а для обозначения самой этой поверхности будет использоваться термин „поверхность-эллипсоид“.

Постановка задачи и сведение ее к задаче для включения с оболочкой в вакууме

Рассмотрим диэлектрическое включение, состоящее из ядра, занимающего область V_2 , и оболочки, занимающей область V_1 , помещенное в бесконечную диэлектрическую среду (матрицу) с внешним приложенным однородным электрическим полем напряженностью \mathbf{E}_0 . Область, занимаемую всем неоднородным включением, обозначим как V . Материалы, составляющие матрицу, оболочку и ядро, предполагаются однородными и анизотропными с тензорами диэлектрической проницаемости ϵ_m, ϵ_1 и ϵ_2 соответственно. Граница S_2 ядра и внешняя граница S_1 оболочки считаются поверхностями-эллипсоидами, становящимися софокусными после линейного неортогонального преобразования, устраняющего анизотропию диэлектрических свойств оболочки [6]. Ставится задача найти распределение потенциала $\varphi(\mathbf{r})$ и напряженности $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\varphi(\mathbf{r})$ электростатического поля в ядре и оболочке данного включения, а также в матрице; область, занимаемую матрицей, обозначим как V_m . Предполагается, что в данной системе свободные заряды отсутствуют.

Математическая формулировка соответствующей краевой задачи для потенциала $\varphi(\mathbf{r})$ имеет вид

$$\nabla \cdot \epsilon_m \nabla \varphi_m(\mathbf{r}) = 0, \quad \mathbf{r} \in V_m, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \epsilon_1 \nabla \varphi_1(\mathbf{r}) = 0, \quad \mathbf{r} \in V_1, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \epsilon_2 \nabla \varphi_2(\mathbf{r}) = 0, \quad \mathbf{r} \in V_2, \quad (3)$$

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = \varphi_1(\mathbf{r}), \quad (\epsilon_m \mathbf{E}_m)_n = (\epsilon_1 \mathbf{E}_1)_n, \quad \mathbf{r} \in S_1, \quad (4)$$

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = \varphi_2(\mathbf{r}), \quad (\epsilon_1 \mathbf{E}_1)_n = (\epsilon_2 \mathbf{E}_2)_n, \quad \mathbf{r} \in S_2, \quad (5)$$

$$\varphi_m|_{\infty} = -(\mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad (6)$$

где $\varphi_m(\mathbf{r})$, \mathbf{E}_m , $\varphi_1(\mathbf{r})$, \mathbf{E}_1 и $\varphi_2(\mathbf{r})$, \mathbf{E}_2 — скалярные потенциалы и напряженности электрического поля в матрице, оболочке и ядре соответственно; \mathbf{n} — вектор единичной нормали к соответствующей поверхности; ∇ — векторный дифференциальный оператор Гамильтона, имеющий в исходных декартовых координатах x^1, x^2, x^3 вид $\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x^1} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial x^2} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial x^3}$. Условия (1)–(3) — это

уравнения в частных производных, которым должен удовлетворять потенциал $\varphi(\mathbf{r})$ в матрице, оболочке и ядре соответственно. Условия (4) и (5) — это непрерывность $\varphi(\mathbf{r})$ и нормальной составляющей вектора электрической индукции $\mathbf{D}(\mathbf{r})$ на границе оболочки и матрицы и на границе ядра и оболочки соответственно. Условие (6) означает, что на бесконечном удалении от включения потенциал $\varphi(\mathbf{r})$ равен потенциалу приложенного поля $\varphi_0 = -(\mathbf{E}_0, \mathbf{r})$. Подразумевается также ограниченность потенциала внутри частицы, вытекающая из физического смысла задачи. Полуоси поверхностей-эллипсоидов $S_i, i = 1, 2$ считаются известными и равными $a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, a_3^{(i)}$.

Сведем задачу (1)–(6) к аналогичной задаче для включения с оболочкой в вакууме; для этого сделаем линейное неортогональное преобразование координат $(\mathbf{r} = (x^1 x^2 x^3)^T, \mathbf{r}' = (x^{1'} x^{2'} x^{3'})^T)$

$$\mathbf{r} = \mathbf{T}_m \mathbf{r}', \quad (7)$$

подобранное таким образом, чтобы (1) преобразовалось к уравнению Лапласа:

$$\nabla \cdot \epsilon_m \nabla \varphi_m(\mathbf{r}) = 0, \quad \mathbf{r} \in V_m \Leftrightarrow \nabla' \cdot \nabla' \varphi_m(\mathbf{T}_m \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in V'_m,$$

где V'_m — область, занимаемая матрицей в системе координат $x^{1'} x^{2'} x^{3'}$. Операторы Гамильтона в системах $x^1 x^2 x^3$ и $x^{1'} x^{2'} x^{3'}$ связаны друг с другом по формуле

$$\nabla = (\mathbf{T}_m^{-1})^T \nabla', \quad (8)$$

а связь тензора ϵ_m с матрицей преобразования (8) имеет вид:

$$\epsilon_m = \mathbf{T}_m \mathbf{T}_m^T. \quad (9)$$

Условно говоря, преобразование (7) устраняет анизотропию диэлектрических свойств матрицы; его также можно рассматривать как преобразование пространства, при этом поверхности-эллипсоиды S_1, S_2 , преобразуются соответственно в поверхности-эллипсоиды S'_1, S'_2 , полуоси которых обозначим как $a_{1'}^{(i)}, a_{2'}^{(i)}, a_{3'}^{(i)}, i = 1, 2$. С целью единственным образом определить преобразование (7) потребуем, наряду с (9), чтобы оси системы координат $x^{1'} x^{2'} x^{3'}$ были направлены вдоль осей поверхности S'_1 с таким соответствием, чтобы ее полуоси были упорядочены: $a_{1'}^{(1)} > a_{2'}^{(1)} > a_{3'}^{(1)}$. Аналогично [6] введем для краткости обозначения для произведений полуосей:

$$\bar{a}^{(i)} = a_1^{(i)} a_2^{(i)} a_3^{(i)}, \quad \bar{a}'^{(i)} = a_{1'}^{(i)} a_{2'}^{(i)} a_{3'}^{(i)}, \quad i = 1, 2. \quad (10)$$

После преобразования (7) условия (1)–(3) примут вид:

$$\nabla' \cdot \nabla' \varphi_m(\mathbf{T}_m \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in V'_m, \quad (11)$$

$$\nabla' \cdot \epsilon'_1 \nabla' \varphi_1(\mathbf{T}_m \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in V'_1, \quad (12)$$

$$\nabla' \cdot \epsilon'_2 \nabla' \varphi_2(\mathbf{T}_m \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in V'_2, \quad (13)$$

где V'_1, V'_2 — образы областей V_1, V_2 при преобразовании (7);

$$\epsilon'_1 = \mathbf{T}_m^{-1} \epsilon_1 (\mathbf{T}_m^{-1})^T, \quad \epsilon'_2 = \mathbf{T}_m^{-1} \epsilon_2 (\mathbf{T}_m^{-1})^T \quad ([15]). \quad (14)$$

Образ области V , занимаемой всем включением, обозначим как V' .

Пусть $f_1(\mathbf{r}) = 0$ и $f_2(\mathbf{r}) = 0$ — уравнения поверхностей S_1, S_2 , тогда

$$\mathbf{n}|_{S_i} = \nabla f_i / |\nabla f_i|^{-1}|_{S_i}, \quad i = 1, 2,$$

и вторые из этих условий (4), (5) можно переписать в виде

$$\begin{aligned} (\nabla f_1, \boldsymbol{\varepsilon}_m \mathbf{E}_m) &= (\nabla f_1, \boldsymbol{\varepsilon}_1 \mathbf{E}_1), \quad \mathbf{r} \in S_1, \\ (\nabla f_2, \boldsymbol{\varepsilon}_1 \mathbf{E}_1) &= (\nabla f_2, \boldsymbol{\varepsilon}_2 \mathbf{E}_2), \quad \mathbf{r} \in S_2. \end{aligned} \quad (15)$$

Напряженность электрического поля, согласно (8), преобразуется по формулам

$$\mathbf{E} = (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{E}', \quad \mathbf{E}' = \mathbf{T}_m^T \mathbf{E}. \quad (16)$$

Запишем равенства (15) в системе координат $x^1 x^2 x^3$. Преобразуем левую часть первого из этих равенств с учетом (8), (9), (16)

$$\begin{aligned} (\nabla f_1, \boldsymbol{\varepsilon}_m \mathbf{E}_m) &= ((\mathbf{T}_m^{-1})^T \nabla' f_1, \boldsymbol{\varepsilon}_m (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{T}_m^T \mathbf{E}_m) \\ &= (\nabla' f_1, (\mathbf{T}_m^{-1}) \boldsymbol{\varepsilon}_m (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{E}'_m) = (\nabla' f_1, \mathbf{E}'_m). \end{aligned}$$

Аналогично для правой части первого равенства с учетом (14) имеем

$$(\nabla f_1, \boldsymbol{\varepsilon}_1 \mathbf{E}_1) = (\nabla' f_1, \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \mathbf{E}'_1),$$

поэтому первое из равенств (15) в системе $x^1 x^2 x^3$ принимает вид

$$(\nabla' f_1, \mathbf{E}'_m) = (\nabla' f_1, \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \mathbf{E}'_1), \quad \mathbf{r}' \in S'_1. \quad (17)$$

Для второго из равенств (15) аналогичным образом получим вид в системе $x^1 x^2 x^3$:

$$(\nabla' f_2, \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \mathbf{E}'_1) = (\nabla' f_2, \boldsymbol{\varepsilon}'_2 \mathbf{E}'_2), \quad \mathbf{r}' \in S'_2. \quad (18)$$

Первые из условий (4), (5) в системе $x^1 x^2 x^3$ можно записать в следующей форме:

$$\varphi'_m(\mathbf{r}') = \varphi'_1(\mathbf{r}'), \quad \mathbf{r}' \in S'_1, \quad (19)$$

$$\varphi'_1(\mathbf{r}') = \varphi'_2(\mathbf{r}'), \quad \mathbf{r}' \in S'_2, \quad (20)$$

где $\varphi'_m(\mathbf{r}') = \varphi_m(\mathbf{T}_m \mathbf{r}')$, $\varphi'_1(\mathbf{r}') = \varphi_1(\mathbf{T}_m \mathbf{r}')$, $\varphi'_2(\mathbf{r}') = \varphi_2(\mathbf{T}_m \mathbf{r}')$. Условие (6) в системе $x^1 x^2 x^3$ примет вид

$$\varphi'_m|_{\infty} = -(\mathbf{E}'_0, \mathbf{r}'). \quad (21)$$

Таким образом, задача (1)–(6) в системе координат $x^1 x^2 x^3$ сводится к системе условий (11)–(13), (17)–(21). Получившаяся задача — это задача для эллипсоидального включения с оболочкой, помещенного в вакуум с однородным приложенным полем. Чтобы показать это, перепишем ее формулировку в координатном

виде (подразумевается суммирование по повторяющимся индексам):

$$\nabla_{k'} \delta^{k'l'} \nabla_{l'} \varphi'_m(\mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in V'_m, \quad (22)$$

$$\nabla_{k'} \boldsymbol{\varepsilon}_1^{k'l'} \nabla_{l'} \varphi'_1(\mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in V'_1, \quad (23)$$

$$\nabla_{k'} \boldsymbol{\varepsilon}_2^{k'l'} \nabla_{l'} \varphi'_2(\mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in V'_2, \quad (24)$$

$$\begin{aligned} \varphi'_m(\mathbf{r}') &= \varphi'_1(\mathbf{r}'), \quad \nabla_{k'} f_1 \delta^{k'l'} (E_m)_{l'} = \nabla_{k'} f_1 \boldsymbol{\varepsilon}_1^{k'l'} (E_1)_{l'}, \\ &\mathbf{r}' \in S'_1, \end{aligned} \quad (25)$$

$$\begin{aligned} \varphi'_1(\mathbf{r}') &= \varphi'_2(\mathbf{r}'), \quad \nabla_{k'} f_2 \boldsymbol{\varepsilon}_1^{k'l'} (E_1)_{l'} = \nabla_{k'} f_2 \boldsymbol{\varepsilon}_2^{k'l'} (E_2)_{l'}, \\ &\mathbf{r}' \in S'_2, \end{aligned} \quad (26)$$

$$\varphi'_m|_{\infty} = -(E_0)_{k'} x^{k'}. \quad (27)$$

Координатная форма (22)–(27) задачи в системе $x^1 x^2 x^3$ не зависит от метрики в этой системе, поэтому можно абстрагироваться от исходной метрики в системе $x^1 x^2 x^3$ и считать, что метрика в системе $x^1 x^2 x^3$ — декартова. Тогда вторые из условий (25), (26) равносильны условиям непрерывности нормальной составляющей электрической индукции на поверхностях S'_1, S'_2 , поэтому задача (22)–(27) — это задача для включения с оболочкой, помещенного в вакуум с однородным приложенным полем \mathbf{E}'_0 . Диэлектрические проницаемости оболочки и ядра включения равны $\boldsymbol{\varepsilon}'_1$ и $\boldsymbol{\varepsilon}'_2$ соответственно.

Решение задачи для включения с оболочкой в вакууме

Решение задачи (22)–(27) известно и имеет вид [6]

$$\begin{aligned} \varphi'_m(\mathbf{r}') &= \left((-\mathbf{I} + 3(\bar{a}''^{(1)})^{-1} \mathbf{N}'(\boldsymbol{\xi}') \boldsymbol{\alpha}') \mathbf{E}'_0, \mathbf{r}' \right), \\ &\mathbf{r}' \in V'_m, \quad \boldsymbol{\xi}' \geq 0, \\ \varphi'_1(\mathbf{r}') &= \left((\boldsymbol{\beta}'^{(1)} + \mathbf{N}_0''(\boldsymbol{\xi}'') \boldsymbol{\alpha}'^{(1)}) \mathbf{E}'_0, \mathbf{r}' \right), \\ &\mathbf{r}' \in V'_1, \quad 0 \leq \boldsymbol{\xi}'' \leq t'', \\ \varphi'_2(\mathbf{r}') &= -(\mathbf{E}'^{(2)}, \mathbf{r}'), \end{aligned} \quad (28)$$

где

$$\mathbf{E}'^{(2)} = \boldsymbol{\lambda}'_{20} \mathbf{E}'_0, \quad (29)$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}' &= 3^{-1} \bar{a}''^{(1)} \left[(\boldsymbol{\varepsilon}'_1 - \mathbf{I})(\mathbf{I} + (\mathbf{L}_0''^{(2)} - v' \mathbf{L}_0''^{(1)})(\boldsymbol{\varepsilon}'_2 - \boldsymbol{\varepsilon}'_1)) \right. \\ &\quad \left. + v'(\boldsymbol{\varepsilon}'_2 - \boldsymbol{\varepsilon}'_1) \right] \boldsymbol{\lambda}'_{20}, \\ \boldsymbol{\alpha}'^{(1)} &= (\boldsymbol{\varepsilon}'_2 - \boldsymbol{\varepsilon}'_1) \boldsymbol{\lambda}'_{20}, \quad \boldsymbol{\beta}'^{(1)} = -(\mathbf{I} + \mathbf{L}_0''^{(2)})(\boldsymbol{\varepsilon}'_2 - \boldsymbol{\varepsilon}'_1) \boldsymbol{\lambda}'_{20}, \\ \boldsymbol{\lambda}'_{20} &= \left[(\mathbf{I} + \mathbf{L}'^{(1)}(\boldsymbol{\varepsilon}'_1 - \mathbf{I})) (\mathbf{I} + (\mathbf{L}_0''^{(2)} - v' \mathbf{L}_0''^{(1)})(\boldsymbol{\varepsilon}'_2 - \boldsymbol{\varepsilon}'_1)) \right. \\ &\quad \left. + v' \mathbf{L}'^{(1)}(\boldsymbol{\varepsilon}'_2 - \boldsymbol{\varepsilon}'_1) \right]^{-1}. \end{aligned} \quad (30)$$

В первом из выражений (28) ξ' — первая из эллипсоидальных координат ξ', η', ξ'' , связанных с координатами $x^1 x^2 x^3$ по формулам

$$(x^{i'})^2 = \frac{(\xi' + (a_{i'}^{(1)})^2)(\eta' + (a_{i'}^{(1)})^2)(\xi' + (a_{i'}^{(1)})^2)}{((a_{j'}^{(1)})^2 - (a_{i'}^{(1)})^2)((a_{k'}^{(1)})^2 - (a_{i'}^{(1)})^2)},$$

$$i' = 1', 2', 3' \quad (i' \neq j' \neq k' \neq i'), \quad (31)$$

$$-(a_{1'}^{(1)})^2 < \xi' < -(a_{2'}^{(1)})^2 < \eta' < -(a_{3'}^{(1)})^2 < \xi' < +\infty;$$

$\mathbf{N}'(\xi')$ — тензорная функция координаты ξ' :

$$\mathbf{N}'(\xi') = \begin{vmatrix} N'_{1'}(\xi') & 0 & 0 \\ 0 & N'_{2'}(\xi') & 0 \\ 0 & 0 & N'_{3'}(\xi') \end{vmatrix}, \quad (32)$$

$$N'_{i'}(\xi') = \frac{\bar{a}'^{(1)}}{2} \int_{\xi'}^{+\infty} \frac{du}{[u + (a_{i'}^{(1)})^2]R_u^{(1)}}, \quad i' = 1', 2', 3', \quad (33)$$

$$R_u^{(1)} = [(u + (a_{1'}^{(1)})^2)(u + (a_{2'}^{(1)})^2)(u + (a_{3'}^{(1)})^2)]^{1/2}. \quad (34)$$

Во втором из выражений (28) ξ'' — первая из эллипсоидальных координат ξ'', η'', ξ''' , связанных с координатами $x^{1''}, x^{2''}, x^{3''}$, которые вводятся с помощью преобразования ($\mathbf{r}'' = (x^{1''} x^{2''} x^{3''})^T$)

$$\mathbf{r}' = \mathbf{T}'_1 \mathbf{r}'', \quad (35)$$

устраняющего анизотропию оболочки после преобразования (7). Его связь с тензором ε'_1 имеет вид

$$\varepsilon'_1 = \mathbf{T}'_1 \mathbf{T}'_1{}^T.$$

Образами поверхностей-эллипсоидов S'_1, S'_2 , при преобразовании (35) являются поверхности-эллипсоиды S''_1, S''_2 , которые предполагаются софокусными; их полуоси, обозначенные как $a_{1''}^{(i)}, a_{2''}^{(i)}, a_{3''}^{(i)}$ ($i = 1, 2$), связаны соотношениями

$$(a_{k''}^{(1)})^2 = (a_{k''}^{(2)})^2 + t'', \quad k'' = 1'', 2'', 3'',$$

где $t'' > 0$ — некоторое число. Координаты ξ'', η'', ξ''' вводятся формулами

$$(x^{i''})^2 = \frac{(\xi'' + (a_{i''}^{(2)})^2)(\eta'' + (a_{i''}^{(2)})^2)(\xi'' + (a_{i''}^{(2)})^2)}{((a_{j''}^{(2)})^2 - (a_{i''}^{(2)})^2)((a_{k''}^{(2)})^2 - (a_{i''}^{(2)})^2)},$$

$$i'' = 1'', 2'', 3''; \quad (i'' \neq j'' \neq k'' \neq i''), \quad (36)$$

$$-(a_{1''}^{(2)})^2 < \xi'' < -(a_{2''}^{(2)})^2 < \eta'' < -(a_{3''}^{(2)})^2 < \xi'' < +\infty.$$

$\mathbf{N}''_0(\xi'')$ — тензорная функция координаты ξ'' , преобразованная к системе координат $x^1 x^2 x^3$ по формуле

$$\mathbf{N}''_0(\xi'') = (\mathbf{T}'_1{}^{-1})^T \mathbf{N}''(\xi'') \mathbf{T}'_1{}^{-1},$$

где $\mathbf{N}''(\xi'')$ — эта же функция в системе $x^{1''} x^{2''} x^{3''}$:

$$\mathbf{N}''(\xi'') = \begin{vmatrix} N''_{1''}(\xi'') & 0 & 0 \\ 0 & N''_{2''}(\xi'') & 0 \\ 0 & 0 & N''_{3''}(\xi'') \end{vmatrix}, \quad (37)$$

$$N''_{i''}(\xi'') = \frac{\bar{a}''^{(2)}}{2} \int_{\xi''}^{+\infty} \frac{du}{[u + (a_{i''}^{(2)})^2]R_u^{(2)}}, \quad i'' = 1'', 2'', 3'', \quad (38)$$

$$R_u^{(k)} = [(u + (a_{1''}^{(k)})^2)(u + (a_{2''}^{(k)})^2)(u + (a_{3''}^{(k)})^2)]^{1/2},$$

$$k = 1, 2, \quad (39)$$

$$\bar{a}''^{(k)} = a_{1''}^{(k)} a_{2''}^{(k)} a_{3''}^{(k)}, \quad k = 1, 2. \quad (40)$$

В выражениях (30) $\mathbf{L}'^{(1)}$ — тензор геометрических факторов эллипсоида V' с поверхностью S'_1 :

$$\mathbf{L}'^{(1)} = \mathbf{N}'(0); \quad (41)$$

$\mathbf{L}''^{(i)}$, $i = 1, 2$ — преобразованные к системе $x^1 x^2 x^3$ тензоры геометрических факторов эллипсоидов, ограниченных снаружи поверхностями S''_i , $i = 1, 2$ соответственно:

$$\mathbf{L}''^{(i)} = (\mathbf{T}'_1{}^{-1})^T \mathbf{L}''^{(i)} \mathbf{T}'_1{}^{-1}, \quad i = 1, 2,$$

где $\mathbf{L}''^{(i)}$, $i = 1, 2$ — эти же тензоры в системе $x^{1''} x^{2''} x^{3''}$; их главные компоненты

$$L''^{(k)}_{i''} = \frac{\bar{a}''^{(k)}}{2} \int_0^{+\infty} \frac{du}{[u + (a_{i''}^{(k)})^2]R_u^{(k)}},$$

$$i'' = 1'', 2'', 3''; \quad k = 1, 2;$$

v' — отношение объемов внутреннего V'_2 и внешнего эллипсоидов V' , которое в силу линейности преобразования (7) равно отношению объема ядра к объему всего включения:

$$v' = \bar{a}'^{(2)}/\bar{a}'^{(1)} = \bar{a}^{(2)}/\bar{a}^{(1)}.$$

Выражения для напряженности электрического поля в матрице (вакууме) и в оболочке имеют вид [6]

$$\mathbf{E}'_m = \left(\mathbf{I} + 3[-(\bar{a}'^{(1)})^{-1} \mathbf{N}'(\xi') + h_1'^{-2} (R_{\xi'}^{(1)})^{-1} \times (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'})] \alpha' \right) \mathbf{E}'_0,$$

$$\mathbf{E}'_1 = \left(-\beta'^{(1)} + [-\mathbf{N}''_0(\xi'') + \bar{a}''^{(2)} h_1''^{-2} (R_{\xi''}^{(2)})^{-1} \times (\mathbf{r}''_{\xi''} \otimes \mathbf{r}''_{\xi''})_0] \alpha'^{(1)} \right) \mathbf{E}'_0, \quad (42)$$

где

$$\mathbf{r}'_{\xi'} \equiv \frac{\partial \mathbf{r}'}{\partial \xi'} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^1}{\xi' + (a_{1'}^{(1)})^2} \frac{x^2}{\xi' + (a_{2'}^{(1)})^2} \frac{x^3}{\xi' + (a_{3'}^{(1)})^2} \right)^T,$$

$$\mathbf{r}_{\xi''}'' \equiv \frac{\partial \mathbf{r}''}{\partial \xi''} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^{1''}}{\xi'' + (a_{1''}^{(2)})^2} \quad \frac{x^{2''}}{\xi'' + (a_{2''}^{(2)})^2} \quad \frac{x^{3''}}{\xi'' + (a_{3''}^{(2)})^2} \right)^T,$$

$$(\mathbf{r}_{\xi''}'' \otimes \mathbf{r}_{\xi''}'')_0 = (\mathbf{T}_1'^{-1})^T (\mathbf{r}_{\xi''}'' \otimes \mathbf{r}_{\xi''}'' \mathbf{T}_1'^{-1})$$

— тензор, преобразованный к системе $x^1 x^2 x^3$, $(\mathbf{r}_{\xi''}'' \otimes \mathbf{r}_{\xi''}'')$ — этот же тензор в системе $x^{1''} x^{2''} x^{3''}$;

$$h_1' = (2R_{\xi'}^{(1)})^{-1} \sqrt{(\xi'' - \eta')(\xi' - \xi')},$$

$$h_1'' = (2R_{\xi''}^{(2)})^{-1} \sqrt{(\xi'' - \eta'')(\xi'' - \xi'')}$$

— первые из коэффициентов Ламе соответствующих эллипсоидальных систем координат. Напряженность электрического поля в ядре включения имеет вид (29).

Получение решения исходной задачи с помощью преобразования решения задачи для включения с оболочкой в вакууме

Чтобы получить решение исходной задачи (1)–(6), нужно выражения (28)–(30), (42) преобразовать к исходной системе координат $x^1 x^2 x^3$. Тензорные величины, определяемые выражениями (30), преобразуются при переходе к системе $x^1 x^2 x^3$ по формулам (обозначаются без штрихов):

$$\lambda_{20} = (\mathbf{T}_m^{-1})^T \lambda_{20}' \mathbf{T}_m^T, \quad \alpha = \mathbf{T}_m \alpha' \mathbf{T}_m^T,$$

$$\alpha^{(1)} = \mathbf{T}_m \alpha'^{(1)} \mathbf{T}_m^T, \quad \beta^{(1)} = (\mathbf{T}_m^{-1})^T \beta'^{(1)} \mathbf{T}_m^T,$$

так как λ_{20} и $\beta^{(1)}$ — ковариантно-контравариантные, а α и $\alpha^{(1)}$ — дважды контравариантные. Элементарными преобразованиями получим для них выражения

$$\lambda_{20} = [(\mathbf{I} + \mathbf{L}_0^{(1)})(\varepsilon_1 - \varepsilon_m)] (\mathbf{I} + (\mathbf{L}_{00}^{(2)} - v' \mathbf{L}_{00}^{(1)})(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + v' \mathbf{L}_0^{(1)}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)]^{-1},$$

$$\alpha = 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} [(\varepsilon_1 - \varepsilon_m)] (\mathbf{I} + (\mathbf{L}_{00}^{(2)} - v' \mathbf{L}_{00}^{(1)})(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + v'(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)] \lambda_{20},$$

$$\alpha^{(1)} = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \lambda_{20}, \quad \beta^{(1)} = -(\mathbf{I} + \mathbf{L}_{00}^{(2)})(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \lambda_{20}, \tag{43}$$

где

$$\mathbf{L}_0^{(1)} = (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{L}'^{(1)} \mathbf{T}_m^{-1}$$

— тензор геометрических факторов эллипсоида с поверхностью S_1' в системе координат $x^1 x^2 x^3$ (он дважды ковариантный);

$$\mathbf{L}_{00}^{(i)} = (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{L}_0''^{(i)} \mathbf{T}_m^{-1}, \quad i = 1, 2$$

— тензоры геометрических факторов эллипсоидов с поверхностями S_i'' , $i = 1, 2$ соответственно в системе $x^1 x^2 x^3$.

Преобразуя выражения (28), (29), (42) к системе координат $x^1 x^2 x^3$, в итоге получим для потенциала и напряженности электрического поля в матрице, оболочке и ядре включения следующие выражения:

$$\begin{aligned} \varphi_m(\mathbf{r}) &= ((-\mathbf{I} + 3(\bar{a}'^{(1)})^{-1} \mathbf{N}'_0(\xi') \alpha) \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_m, \quad \xi' \geq 0, \\ \varphi_1(\mathbf{r}) &= ((\beta^{(1)} + \mathbf{N}_{00}''(\xi'') \alpha^{(1)}) \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_1, \quad 0 \leq \xi'' \leq t'', \\ \varphi_2(\mathbf{r}) &= -(\lambda_{20} \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \end{aligned} \tag{44}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_m &= (\mathbf{I} + 3[-(\bar{a}'^{(1)})^{-1} \mathbf{N}'_0(\xi') + h_1'^{-2} (R_{\xi'}^{(1)})^{-1} \\ &\quad \times (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'})_0] \alpha) \mathbf{E}_0, \\ \mathbf{E}_1 &= (-\beta^{(1)} + [-\mathbf{N}_{00}''(\xi'') + \bar{a}''^{(2)} h_1''^{-2} (R_{\xi''}^{(2)})^{-1} \\ &\quad \times (\mathbf{r}''_{\xi''} \otimes \mathbf{r}''_{\xi''})_{00}] \alpha^{(1)}) \mathbf{E}_0, \\ \mathbf{E}_2 &= \lambda_{20} \mathbf{E}_0, \end{aligned} \tag{45}$$

где

$$\begin{aligned} \mathbf{N}'_0(\xi') &= (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{N}'(\xi') \mathbf{T}_m^{-1}, \quad \mathbf{N}_{00}''(\xi'') = (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{N}_{00}''(\xi'') \mathbf{T}_m^{-1}, \\ (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'})_0 &= (\mathbf{T}_m^{-1})^T (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'}) \mathbf{T}_m^{-1}, \\ (\mathbf{r}''_{\xi''} \otimes \mathbf{r}''_{\xi''})_{00} &= (\mathbf{T}_m^{-1})^T (\mathbf{r}''_{\xi''} \otimes \mathbf{r}''_{\xi''})_0 \mathbf{T}_m^{-1} \end{aligned} \tag{46}$$

— соответствующие тензорные величины в системе $x^1 x^2 x^3$.

Дипольный момент и тензор поляризуемости включения с оболочкой в анизотропной среде

Потенциал точечного заряда q в анизотропной среде, расположенного в начале координат, имеет выражение [10]

$$\varphi_q = (\det \varepsilon_m)^{-1/2} (\mathbf{r}^T \varepsilon_m^{-1} \mathbf{r})^{-1/2} q, \tag{47}$$

где ε_m — тензор диэлектрической проницаемости среды. Потенциал такого же по абсолютной величине, но противоположного по знаку заряда $-q$, расположенного в близкой к началу координат точке $-\mathbf{dr}$, равен

$$\varphi'_{-q} = -(\det \varepsilon_m)^{-1/2} ((\mathbf{r} + \mathbf{dr})^T \varepsilon_m^{-1} (\mathbf{r} + \mathbf{dr}))^{-1/2} q. \tag{48}$$

Складывая (47) и (48) и линеаризуя по \mathbf{dr} , получим потенциал точечного диполя с моментом $\mathbf{p} = q \mathbf{dr}$ в анизотропной среде

$$\varphi_p = (\det \varepsilon_m)^{-1/2} (\mathbf{r}^T \varepsilon_m^{-1} \mathbf{r})^{-3/2} (\varepsilon_m^{-1} \mathbf{p}, \mathbf{r}). \tag{49}$$

Для нахождения дипольного момента включения с оболочкой рассмотрим первое из выражений (44) для потенциала поля φ_m в матрице в асимптотике при $r \rightarrow \infty$. Так как $\xi' \approx r'^2 \equiv \mathbf{r}'^2$, $\xi' \rightarrow +\infty$, то

$$\mathbf{N}'(\xi') \approx 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} \xi'^{-3/2} \mathbf{I} \approx 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} r'^{-3} \mathbf{I}, \quad \xi' \rightarrow +\infty,$$

$$\mathbf{N}'_0(\xi') \approx 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} r'^{-3} (\mathbf{T}_m^{-1})^T \mathbf{I} \mathbf{T}_m^{-1} = 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} r'^{-3} \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1},$$

$$\xi' \rightarrow +\infty.$$

Поскольку $r'^2 = (\mathbf{r}^T \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1} \mathbf{r})$, то

$$\mathbf{N}'_0(\xi') \approx 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} (\mathbf{r}^T \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1} \mathbf{r})^{-3/2} \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1}, \quad \xi', r \rightarrow +\infty,$$

и для φ_m получим

$$\varphi_m \approx ((-\mathbf{I} + (\mathbf{r}^T \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1} \mathbf{r})^{-3/2} \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1} \boldsymbol{\alpha}) \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad r \rightarrow +\infty,$$

причем потенциал возмущенного поля

$$\varphi_p = \varphi_m - \varphi_0 \approx ((\mathbf{r}^T \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1} \mathbf{r})^{-3/2} \boldsymbol{\varepsilon}_m^{-1} \boldsymbol{\alpha} \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad r \rightarrow +\infty.$$

Сопоставляя это выражение с потенциалом точечного диполя (49), найдем дипольный момент включения с оболочкой

$$\mathbf{p} = (\det \boldsymbol{\varepsilon}_m)^{1/2} \boldsymbol{\alpha} \mathbf{E}_0,$$

откуда видно, что тензор поляризуемости включения

$$\bar{\boldsymbol{\alpha}} = (\det \boldsymbol{\varepsilon}_m)^{1/2} \boldsymbol{\alpha}, \quad (50)$$

где $\boldsymbol{\alpha}$ определяется формулой (43). Поскольку

$$(\det \boldsymbol{\varepsilon}_m)^{1/2} \bar{a}'^{(1)} = \bar{a}^{(1)},$$

перепишем выражение для тензора поляризуемости включения в виде

$$\bar{\boldsymbol{\alpha}} = 3^{-1} \bar{a}^{(1)} \left[(\boldsymbol{\varepsilon}_1 - \boldsymbol{\varepsilon}_m) (\mathbf{I} + (\mathbf{L}_{00}''^{(2)} - \nu' \mathbf{L}_{00}''^{(1)}) (\boldsymbol{\varepsilon}_2 - \boldsymbol{\varepsilon}_1)) + \nu' (\boldsymbol{\varepsilon}_2 - \boldsymbol{\varepsilon}_1) \right] \lambda_{20}. \quad (51)$$

Включение с изотропной оболочкой в анизотропной среде

Рассмотрим частный, но важный для приложений случай, когда оболочка включения имеет изотропные материальные характеристики, т. е. тензор диэлектрической проницаемости оболочки имеет вид

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \varepsilon_1 \mathbf{I}. \quad (52)$$

В этом случае, очевидно, преобразование (35), устраняющее анизотропию оболочки после преобразования (7), т. е. сводящее $\boldsymbol{\varepsilon}'_1$ к единичному тензору \mathbf{I} , есть

$$\mathbf{T}'_1 = \mathbf{T}_m^{-1} \sqrt{\varepsilon_1} \mathbf{I},$$

При этом координатные системы $x^{1''} x^{2''} x^{3''}$ и $x^1 x^2 x^3$ связаны между собой соотношениями

$$x^i = \sqrt{\varepsilon_1} x^{i''}, \quad i = 1, 2, 3; \quad i'' = 1'', 2'', 3'', \quad (53)$$

или в векторном виде

$$\mathbf{r} = \mathbf{T}_1 \mathbf{r}'', \quad \mathbf{T}_1 = \sqrt{\varepsilon_1} \mathbf{I}.$$

Софокусность поверхностей-эллипсоидов при изотропном растяжении сохраняется, поэтому софокусными считаются исходные поверхности-эллипсоиды S_1, S_2 , т. е.

$$(a_k^{(1)})^2 = (a_k^{(2)})^2 + t, \quad k = 1, 2, 3,$$

где $t > 0$ — „шаг софокусности“. Полуоси поверхностей-эллипсоидов S_i и S''_i , $i = 1, 2$ связаны между собой, согласно (53):

$$a_{k''}^{(i)} = (\varepsilon_1)^{-1/2} a_k^{(i)}, \quad k = 1, 2, 3; \quad k'' = 1'', 2'', 3''; \quad i = 1, 2,$$

при этом для „шага софокусности“ поверхностей S_1, S_2 имеем

$$t = \varepsilon_1 t''.$$

Введем эллипсоидальные координаты ξ, η, ζ , связанные с координатами x^1, x^2, x^3 по формулам:

$$(x^i)^2 = \frac{(\xi + (a_i^{(2)})^2)(\eta + (a_i^{(2)})^2)(\zeta + (a_i^{(2)})^2)}{((a_j^{(2)})^2 - (a_i^{(2)})^2)((a_k^{(2)})^2 - (a_i^{(2)})^2)},$$

$$i = 1, 2, 3; \quad (i \neq j \neq k \neq i), \quad (54)$$

где $-(a_1^{(2)})^2 < \xi < -(a_2^{(2)})^2 < \eta < -(a_3^{(2)})^2 < \zeta < +\infty$. Значению координаты $\xi = 0$ соответствует положение точек на внутренней поверхности S_2 . Связь координат ξ, η, ζ с координатами ξ'', η'', ζ'' , введенными формулами (36), имеет вид

$$\xi = \varepsilon_1 \xi'', \quad \eta = \varepsilon_1 \eta'', \quad \zeta = \varepsilon_1 \zeta''. \quad (55)$$

Введем тензорную функцию $\mathbf{N}(\xi)$ переменной ξ , имеющую в системе $x^1 x^2 x^3$ вид

$$\mathbf{N}(\xi) = \begin{vmatrix} N_1(\xi) & 0 & 0 \\ 0 & N_2(\xi) & 0 \\ 0 & 0 & N_3(\xi) \end{vmatrix}, \quad (56)$$

$$N_i(\xi) = \frac{\bar{a}^{(2)}}{2} \int_{\xi}^{+\infty} \frac{du}{[u + (a_i^{(2)})^2] R_u^{(2)}}, \quad i = 1, 2, 3; \quad 0 \leq \xi \leq t, \quad (57)$$

где

$$R_u^{(k)} = [(u + (a_1^{(k)})^2)(u + (a_2^{(k)})^2)(u + (a_3^{(k)})^2)]^{1/2},$$

$$k = 1, 2.$$

С помощью элементарных преобразований нетрудно убедиться, что

$$\mathbf{N}''(\xi'') = \mathbf{N}(\xi),$$

где $\mathbf{N}''(\xi'')$ — тензорная функция, определяемая выражениями (37)–(40). Тогда для этой же тензорной функции в системе $x^1 x^2 x^3$ получим

$$\mathbf{N}''_{00}(\xi'') = (\mathbf{T}_1^{-1})^T \mathbf{N}''(\xi'') \mathbf{T}_1^{-1} = \varepsilon_1^{-1} \mathbf{N}(\xi). \quad (58)$$

Далее, так как для тензоров геометрических факторов эллипсоидов с поверхностями S_1'', S_2'' имеют место соотношения $\mathbf{L}_{00}''^{(2)} = \mathbf{N}_{00}''^{(1)}(0)$, $\mathbf{L}_{00}''^{(1)} = v'^{-1}\mathbf{N}_{00}''^{(2)}(t'')$, то

$$\mathbf{L}_{00}''^{(k)} = \varepsilon_1^{-1}\mathbf{L}^{(k)}, \quad k = 1, 2, \quad (59)$$

где $\mathbf{L}^{(1)}, \mathbf{L}^{(2)}$ — тензоры геометрических факторов эллипсоидов с поверхностями S_1, S_2 соответственно:

$$\mathbf{L}^{(1)} = v'^{-1}\mathbf{N}(t), \quad \mathbf{L}^{(2)} = \mathbf{N}(0),$$

их главные компоненты

$$L_i^{(k)} = \frac{\bar{a}^{(k)}}{2} \int_0^{+\infty} \frac{du}{[u + (a_i^{(k)})^2]R_u^{(k)}}, \quad i = 1, 2, 3; \quad k = 1, 2. \quad (60)$$

Упростим выражение для тензора $(\mathbf{r}_{\xi''}'' \otimes \mathbf{r}_{\xi''}'')_{00}$ в случае изотропной оболочки. С учетом (53) и (55)

$$\mathbf{r}_{\xi''}'' = \sqrt{\varepsilon_1} \mathbf{r}_{\xi},$$

где

$$\mathbf{r}_{\xi} \equiv \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \xi} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^1}{\xi + (a_1^{(2)})^2} \frac{x^2}{\xi + (a_2^{(2)})^2} \frac{x^3}{\xi + (a_3^{(2)})^2} \right)^T, \quad (61)$$

тогда

$$\mathbf{r}_{\xi''}'' \otimes \mathbf{r}_{\xi''}'' = \varepsilon_1 (\mathbf{r}_{\xi} \otimes \mathbf{r}_{\xi}),$$

поэтому

$$(\mathbf{r}_{\xi''}'' \otimes \mathbf{r}_{\xi''}'')_{00} = \varepsilon_1^{-1} (\mathbf{r}_{\xi''}'' \otimes \mathbf{r}_{\xi''}'') = (\mathbf{r}_{\xi} \otimes \mathbf{r}_{\xi}), \quad (62)$$

Для коэффициента Ламе h_1'' и выражения $R_{\xi''}''^{(2)}$ имеем

$$h_1'' = \sqrt{\varepsilon_1} h_1, \quad R_{\xi''}''^{(2)} = \varepsilon_1^{-3/2} R_{\xi}^{(2)},$$

где

$$h_1 = (2R_{\xi}^{(2)})^{-1} \sqrt{(\xi - \eta)(\xi - \zeta)}. \quad (63)$$

С учетом соотношений (52), (59) выражения (43) для тензоров $\lambda_{20}, \alpha, \alpha^{(1)}, \beta^{(1)}$ принимают вид

$$\begin{aligned} \lambda_{20} &= [(\mathbf{I} + \mathbf{L}_0^{(1)})(\varepsilon_1 \mathbf{I} - \varepsilon_m)] (\mathbf{I} + \varepsilon_1^{-1}(\mathbf{L}^{(2)} - v'\mathbf{L}^{(1)}) \\ &\quad \times (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) + v'\mathbf{L}_0^{(1)}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})]^{-1}, \\ \alpha &= 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} [(\varepsilon_1 \mathbf{I} - \varepsilon_m)] (\mathbf{I} + \varepsilon_1^{-1}(\mathbf{L}^{(2)} - v'\mathbf{L}^{(1)}) \\ &\quad \times (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) + v'(\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})] \lambda_{20}, \end{aligned}$$

$$\alpha^{(1)} = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) \lambda_{20}, \quad \beta^{(1)} = -(\mathbf{I} + \varepsilon_1^{-1} \mathbf{L}^{(2)} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})) \lambda_{20}. \quad (64)$$

Выражения для потенциала и напряженности электрического поля в матрице и ядре остаются такими же, как и в (44), (45), а выражения для них в оболочке с

учетом (58), (61), (62) немного упрощаются. Выпишем для удобства все указанные выражения

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = ((-\mathbf{I} + 3(\bar{a}'^{(1)})^{-1} \mathbf{N}'_0(\xi') \alpha) \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_m, \xi' \geq 0,$$

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = ((\beta^{(1)} + \varepsilon_1^{-1} \mathbf{N}(\xi) \alpha^{(1)}) \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_1, \quad 0 \leq \xi \leq t,$$

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = -(\lambda_{20} \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad (65)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_m &= (\mathbf{I} + 3[-(\bar{a}'^{(1)})^{-1} \mathbf{N}'_0(\xi') + h_1'^{-2} (R_{\xi'}^{(1)})^{-1} \\ &\quad \times (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'})_0] \alpha) \mathbf{E}_0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 &= (-\beta^{(1)} + \varepsilon_1^{-1} [-\mathbf{N}(\xi) + \bar{a}^{(2)} h_1^{-2} (R_{\xi}^{(2)})^{-1} \\ &\quad \times (\mathbf{r}_{\xi} \otimes \mathbf{r}_{\xi})] \alpha^{(1)}) \mathbf{E}_0, \end{aligned}$$

$$\mathbf{E}_2 = \lambda_{20} \mathbf{E}_0, \quad (66)$$

где $\mathbf{N}(\xi), R_{\xi}^{(2)}, (\mathbf{r}_{\xi} \otimes \mathbf{r}_{\xi}), h_1$ определяются выражениями (56)–(57), (60), (61), (63) соответственно.

Примеры

1. Рассмотрим случай анизотропного шара с изотропной сферической оболочкой в анизотропной матрице. Пусть $a^{(1)}, a^{(2)}$ — радиусы внешней и внутренней сфер S_1, S_2 . Направим оси системы координат $x^1 x^2 x^3$ вдоль главных осей тензора ε_m , тогда матрица преобразования (7) будет иметь в системе $x^1 x^2 x^3$ вид

$$\mathbf{T}_m = \begin{pmatrix} (\varepsilon_1^{(m)})^{1/2} & 0 & 0 \\ 0 & (\varepsilon_2^{(m)})^{1/2} & 0 \\ 0 & 0 & (\varepsilon_3^{(m)})^{1/2} \end{pmatrix},$$

где $\varepsilon_k^{(m)}, k = 1, 2, 3$ — главные компоненты тензора ε_m . Сферы S_1, S_2 при преобразовании (7) переходят в поверхности-эллипсоиды S_1', S_2' с полуосями

$$a_{k'}^{(i)} = (\varepsilon_k^{(m)})^{1/2} a^{(i)}, \quad k = 1, 2, 3; \quad k' = 1', 2', 3'; \quad i = 1, 2. \quad (67)$$

Для главных компонент тензорной функции $\mathbf{N}'(\xi')$ в соответствии с (67) получаем

$$\begin{aligned} N'_{k'}(\xi') &= \frac{(a^{(1)})^3}{2(\varepsilon_1^{(m)} \varepsilon_2^{(m)} \varepsilon_3^{(m)})^{1/2}} \int_{\xi'}^{+\infty} \frac{du}{[u + (\varepsilon_k^{(m)})^{-1} (a^{(1)})^2] R_u^{(1)}}, \\ &\quad k' = 1', 2', 3', \end{aligned} \quad (68)$$

где

$$R_u^{(1)} = \left[\prod_{k=1}^3 (u + (\varepsilon_k^{(m)})^{-1} (a^{(1)})^2) \right]^{1/2}, \quad (69)$$

для главных компонент $\mathbf{N}'_0(\xi')$ имеем

$$N'_{0,k'}(\xi') = (\varepsilon_k^{(m)})^{-1} N'_{k'}(\xi'), \quad k = 1, 2, 3; \quad k' = 1', 2', 3'. \quad (70)$$

В соответствии с (41) для главных компонент тензора $\mathbf{L}'_0^{(1)}$ имеем выражения

$$L'_{0,k'}^{(1)} = (\varepsilon_k^{(m)})^{-1} N'_{k'}(0), \quad k = 1, 2, 3; \quad k' = 1', 2', 3'. \quad (71)$$

Несложно проверить, что в случае вырождения поверхности-эллипсоида S_2 в сферу для координат ξ, η, ζ , определяемых формулами (54), получаются предельные выражения

$$\xi \rightarrow r^2 - (a^{(2)})^2, \quad \eta, \zeta \rightarrow -(a^{(2)})^2,$$

поэтому непосредственным вычислением по формулам (57), (63) для $\mathbf{N}(\xi), R_\xi^{(2)}, h_1$ получаем

$$\mathbf{N}(\xi) = 3^{-1}(a^{(2)}/r)^3 \mathbf{I}, \quad R_\xi^{(2)} = r^3, \quad h_1 = 1/(2r). \quad (72)$$

Имеем также в данном случае

$$\mathbf{r}_\xi \otimes \mathbf{r}_\xi = 4^{-1} r^{-4} \mathbf{r} \otimes \mathbf{r}, \quad \mathbf{L}^{(1)} = \mathbf{L}^{(2)} = 3^{-1} \mathbf{I}.$$

Выражения (64) для тензоров $\lambda_{20}, \alpha, \alpha^{(1)}, \beta^{(1)}$ принимают вид

$$\lambda_{20} = [(\mathbf{I} + \mathbf{L}'_0^{(1)} \varepsilon_1 \mathbf{I} - \varepsilon_m)] (\mathbf{I} + 3^{-1} \varepsilon_1^{-1} (1 - v')) \times (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) + v' \mathbf{L}'_0^{(1)} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})^{-1},$$

$$\alpha = 3^{-1} (\varepsilon_1^{(m)} \varepsilon_2^{(m)} \varepsilon_3^{(m)})^{-1/2} (a^{(1)})^3 [(\varepsilon_1 \mathbf{I} - \varepsilon_m) (\mathbf{I} + 3^{-1} \varepsilon_1^{-1} (1 - v') (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})) + v' (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})] \lambda_{20},$$

$$\alpha^{(1)} = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) \lambda_{20}, \quad \beta^{(1)} = -(\mathbf{I} + 3^{-1} \varepsilon_1^{-1} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})) \lambda_{20}. \quad (73)$$

Таким образом, потенциал и напряженность электрического поля в сферической оболочке задаются следующими выражениями:

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = ((\beta^{(1)} + 3^{-1} \varepsilon_1^{-1} (a^{(2)}/r)^3 \alpha^{(1)}) \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_1, \quad a^{(2)} \leq r \leq a^{(1)}, \quad (74)$$

$$\mathbf{E}_1 = (-\beta^{(1)} + \varepsilon_1^{-1} [-3^{-1} \varepsilon_1^{-1} + (a^{(2)}/r)^3 \mathbf{I} + (a^{(2)})^3 \times r^{-5} (\mathbf{r} \otimes \mathbf{r})] \alpha^{(1)}) \mathbf{E}_0, \quad (75)$$

потенциал и напряженность электрического поля в матрице и ядре включения — соответствующими выражениями из (65) и (66) с учетом того, что $\lambda_{20}, \alpha, \alpha^{(1)}, \beta^{(1)}$ определяются из (73).

2. Для случая анизотропного шара с изотропной сферической оболочкой в изотропной матрице преобразование (7) становится изотропным сжатием

$$\mathbf{T}_m = \sqrt{\varepsilon_m} \mathbf{I}.$$

где ε_m — скалярная диэлектрическая проницаемость матрицы, при этом существенно упрощаются выражения (67)–(71):

$$a_{k'}^{(i)} = (\varepsilon_m)^{-1/2} a^{(i)}, \quad k' = 1', 2', 3'; \quad i = 1, 2.$$

В случае вырождения поверхности-эллипсоида S_1 в сферу для координат ξ', η', ζ' определяемой формулами (31) получаются предельные выражения:

$$\xi' \rightarrow r'^2 - (a'^{(1)})^2 = \varepsilon_m^{-1} (r^2 - (a^{(1)})^2),$$

$$\eta', \zeta' \rightarrow -(a'^{(1)})^2 = -\varepsilon_m^{-1} (a^{(1)})^2,$$

поэтому для тензорной функции $\mathbf{N}'(\xi')$ имеем аналогично (72)

$$\mathbf{N}'(\xi') = 3^{-1} (a^{(1)}/r)^3 \mathbf{I},$$

откуда

$$\mathbf{N}'_0(\xi') = 3^{-1} \varepsilon_m^{-1} (a^{(1)}/r)^3 \mathbf{I}, \quad \mathbf{L}'_0^{(1)} = 3^{-1} \varepsilon_m^{-1} \mathbf{I}.$$

Также имеем

$$R_{\xi'}^{(1)} = \varepsilon_m^{-3/2} r^3, \quad h'_1 = 1/(2r), \quad (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'})_0 = 4^{-1} r^{-4} \mathbf{r} \otimes \mathbf{r}.$$

Выражения для тензоров $\lambda_{20}, \alpha, \alpha^{(1)}, \beta^{(1)}$ принимают вид

$$\lambda_{20} = 9 \varepsilon_m \varepsilon_1 [(1 - v') (2\varepsilon_m + \varepsilon_1) (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) + 3\varepsilon_1 (2\varepsilon_m + \varepsilon_1 + v' (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}))]^{-1},$$

$$\alpha = 9^{-1} \varepsilon_m^{-3/2} \varepsilon_1^{-1} (a^{(1)})^3 [(\varepsilon_1 - \varepsilon_m) (2\varepsilon_1 \mathbf{I} + \varepsilon_2) + v' (2\varepsilon_1 + \varepsilon_m) (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})] \lambda_{20},$$

$$\alpha^{(1)} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) \lambda_{20}, \quad \beta^{(1)} = -3^{-1} \varepsilon_1^{-1} (2\varepsilon_1 \mathbf{I} + \varepsilon_2) \lambda_{20}. \quad (76)$$

Потенциал и напряженность электрического поля в сферической оболочке задаются формулами (74) и (75) соответственно, потенциал и напряженность в ядре включения — соответствующими формулами из (65) и (66) с учетом того, что λ_{20} определяется из (76), а потенциал и напряженность в матрице — следующими выражениями:

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = ((-\mathbf{I} + \varepsilon_m^{1/2} r^{-3} \alpha) \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_m,$$

$$\mathbf{E}_m = (\mathbf{I} + 3[-3^{-1} \varepsilon_m^{1/2} r^{-3} \mathbf{I} + \varepsilon_m^{3/2} r^{-5} (\mathbf{r} \otimes \mathbf{r})] \alpha) \mathbf{E}_0.$$

Для тензора поляризуемости в соответствии с (50) имеем формулу

$$\tilde{\alpha} = (a^{(1)})^3 \varepsilon_m [(\varepsilon_1 - \varepsilon_m) (2\varepsilon_1 \mathbf{I} + \varepsilon_2) + v' (2\varepsilon_1 + \varepsilon_m) \times (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I})] [(1 - v') (2\varepsilon_m + \varepsilon_1) (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}) + 3\varepsilon_1 (2\varepsilon_m + \varepsilon_1 + v' (\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \mathbf{I}))]^{-1},$$

являющуюся обобщением известного результата [8,9] на включение с анизотропным ядром.

3. Рассмотрим один из предельных случаев, когда задача (1)–(6) сводится к задаче для однородного эллипсоидального включения в анизотропной среде. Пусть $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$, т.е. оболочка и ядро сливаются. Тогда формулы (43) принимают вид

$$\lambda_{20} = (\mathbf{I} + \mathbf{L}'_0^{(1)} (\varepsilon_1 - \varepsilon_m))^{-1},$$

$$\alpha = 3^{-1} \bar{a}'^{(1)} (\epsilon_1 - \epsilon_m) (\mathbf{I} + \mathbf{L}_0'^{(1)} (\epsilon_1 - \epsilon_m))^{-1},$$

$$\alpha^{(1)} = 0, \quad \beta^{(1)} = -(\mathbf{I} + \mathbf{L}_0'^{(1)} (\epsilon_1 - \epsilon_m))^{-1}. \quad (77)$$

Для потенциала, согласно (44), с учетом (77) имеем

$$\varphi_m(\mathbf{r}) = ([-\mathbf{I} + \mathbf{N}_0'(\xi') (\epsilon_1 - \epsilon_m) \times (\mathbf{I} + \mathbf{L}_0'^{(1)} (\epsilon_1 - \epsilon_m))^{-1}] \mathbf{E}_0, \mathbf{r}),$$

$$\mathbf{r} \in V_m, \quad \xi' \geq 0,$$

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = (-[\mathbf{I} + \mathbf{L}_0'^{(1)} (\epsilon_1 - \epsilon_m)]^{-1} \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_1,$$

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = (-[\mathbf{I} + \mathbf{L}_0'^{(1)} (\epsilon_1 - \epsilon_m)]^{-1} \mathbf{E}_0, \mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in V_2.$$

Напряженность электрического поля \mathbf{E}_m в матрице выражается первой из формул (45), а напряженности поля в оболочке и ядре постоянны и равны друг другу:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_2 = (\mathbf{I} + \mathbf{L}_0'^{(1)} (\epsilon_1 - \epsilon_m))^{-1} \mathbf{E}_0. \quad (78)$$

Выражение (78) совпадает с формулой для напряженности поля внутри эллипсоида с поверхностью S_1 , помещенного в анизотропную среду с приложенным постоянным полем, полученной в [15]. Покажем, что выражения (78) и (45) для напряженности поля внутри эллипсоида и в матрице равносильны следующим выражениям, полученным в [7]:

$$\mathbf{E}_1 = (\mathbf{I} - \mathbf{S}(\mathbf{I} - \epsilon_m^{-1} \epsilon_1)^{-1})^{-1} \mathbf{E}_0, \quad (79)$$

$$\mathbf{E}_m = (\mathbf{I} + \mathbf{S}^\infty(\mathbf{r}) [(\mathbf{I} - \epsilon_m^{-1} \epsilon_1)^{-1} - \mathbf{S}]^{-1}) \mathbf{E}_0.$$

где \mathbf{S} и $\mathbf{S}^\infty(\mathbf{r})$ — внутренний и внешний электрические тензоры Эшелби:

$$\mathbf{S} = \frac{\det(\mathbf{a})}{2} \int_0^{+\infty} \frac{[\mathbf{a}^2 + s \epsilon_m]^{-1} \epsilon_m ds}{\sqrt{\det(\mathbf{a}^2 + s \epsilon_m)}},$$

$$\mathbf{S}^\infty(\mathbf{r}) = \frac{\det(\mathbf{a})}{2} \int_{\xi'}^{+\infty} \frac{[\mathbf{a}^2 + s \epsilon_m]^{-1} \epsilon_m ds}{\sqrt{\det(\mathbf{a}^2 + s \epsilon_m)}} - \frac{\det(\mathbf{a})}{\sqrt{\det(\mathbf{a}^2 + s \epsilon_m)}}$$

$$\times \frac{[(\mathbf{a}^2 + \xi' \epsilon_m)^{-1} \mathbf{r}] [\epsilon_m (\mathbf{a}^2 + \xi' \epsilon_m)^{-1} \mathbf{r}]^T}{[(\mathbf{a}^2 + \xi' \epsilon_m)^{-1} \mathbf{r}]^T [\epsilon_m (\mathbf{a}^2 + \xi' \epsilon_m)^{-1} \mathbf{r}]}, \quad (80)$$

где \mathbf{a} — тензор, диагональный в системе главных осей эллипсоида с поверхностью S_1 , главными компонентами которого являются полуоси поверхности S_1 $a_k^{(1)}$, $k = 1, 2, 3$; величина ξ' неявным образом определяется из уравнения

$$\mathbf{r}^T (\mathbf{a}^2 + \xi' \epsilon_m)^{-1} \mathbf{r} = 1. \quad (81)$$

Тензор \mathbf{a}^2 — обратный к тензору \mathbf{S}_1 квадратичной формы поверхности-эллипсоида S_1 , поэтому он преобразуется как дважды контравариантный при замене системы координат, и после преобразования координат (7)

он будет иметь диагональный вид

$$\mathbf{a}^2 = \mathbf{T}_m^{-1} \mathbf{a}^2 (\mathbf{T}_m^{-1})^T = \begin{pmatrix} (a_{1'}^{(1)})^2 & 0 & 0 \\ 0 & (a_{2'}^{(1)})^2 & 0 \\ 0 & 0 & (a_{3'}^{(1)})^2 \end{pmatrix},$$

так как оси системы координат $x^1 x^2 x^3$ направлены вдоль осей поверхности-эллипсоида S_1' . В системе $x^{1'} x^{2'} x^{3'}$ уравнение (81) выглядит следующим образом:

$$\mathbf{r}'^T (\mathbf{a}'^2 + \xi' \mathbf{I})^{-1} \mathbf{r}' = 1,$$

откуда следует, что оно есть уравнение поверхности-эллипсоида, софокусной с S_1' , а ξ' — это первая из эллипсоидальных координат ξ', η', ξ' , вводимых формулами (31). Преобразуем первое слагаемое в выражении (80) для $\mathbf{S}^\infty(\mathbf{r})$:

$$\frac{\det(\mathbf{a})}{2} \int_{\xi'}^{+\infty} \frac{[\mathbf{a}^2 + s \epsilon_m]^{-1} \epsilon_m ds}{\sqrt{\det(\mathbf{a}^2 + s \epsilon_m)}} = \frac{\sqrt{\det(\mathbf{T}_m \mathbf{a}'^2 \mathbf{T}_m^T)}}{2}$$

$$\times \int_{\xi'}^{+\infty} \frac{[\mathbf{T}_m (\mathbf{a}'^2 + s \mathbf{I}) \mathbf{T}_m^T]^{-1} ds}{\sqrt{\det(\mathbf{T}_m (\mathbf{a}'^2 + s \mathbf{I}) \mathbf{T}_m^T)}} \epsilon_m = (\mathbf{T}_m^T)^{-1} \frac{\det(\mathbf{a}')}{2}$$

$$\times \int_{\xi'}^{+\infty} \frac{[\mathbf{a}'^2 + s \mathbf{I}]^{-1} ds}{\sqrt{\det(\mathbf{a}'^2 + s \mathbf{I})}} \mathbf{T}_m^{-1} \epsilon_m = (\mathbf{T}_m^T)^{-1} \mathbf{N}'(\xi') \mathbf{T}_m^{-1} \epsilon_m$$

$$= \mathbf{N}'_0(\xi') \epsilon_m, \quad (82)$$

где $\mathbf{N}'(\xi')$ определяется формулами (32)–(34), $\mathbf{N}'_0(\xi')$ — формулой (46). С помощью аналогичных преобразований можно показать, что второе слагаемое в выражении для $\mathbf{S}^\infty(\mathbf{r})$ приводится к следующей форме:

$$-\det(\mathbf{a}') h_1'^{-2} (R_{\xi'}^{(1)})^{-1} (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'})_0 \epsilon_m,$$

поэтому для $\mathbf{S}^\infty(\mathbf{r})$ в итоге имеем выражение

$$\mathbf{S}^\infty(\mathbf{r}) = [\mathbf{N}'_0(\xi') - \det(\mathbf{a}') h_1'^{-2} (R_{\xi'}^{(1)})^{-1} (\mathbf{r}'_{\xi'} \otimes \mathbf{r}'_{\xi'})_0] \epsilon_m. \quad (83)$$

Поскольку $\mathbf{L}_0^{(1)} = \mathbf{N}'_0(0)$, из (80), (82) сразу вытекает, что

$$\mathbf{S} = \mathbf{L}_0^{(1)} \epsilon_m. \quad (84)$$

Подставляя (83), (84) в (79), после элементарных преобразований получим выражения, в точности совпадающие с (78) и (45). В [8] приведено выражение для напряженности электрического поля внутри эллипсоида в анизотропной матрице, равносильное (79), (80), но немного отличающееся по форме.

Замечание. Из (82) следует, что тензоры $\mathbf{N}'_0(\xi')$ и $\mathbf{N}'_{00}(\xi')$, входящие в выражения (44), (45), могут быть записаны в виде

$$\mathbf{N}'_0(\xi') = \frac{\det(\mathbf{a}^{(1)})}{2} \int_{\xi'}^{+\infty} \frac{[(\mathbf{a}^{(1)})^2 + s \epsilon_m]^{-1} ds}{\sqrt{\det((\mathbf{a}^{(1)})^2 + s \epsilon_m)}},$$

$$N_{00}''(\xi'') = \frac{\det(\mathbf{a}^{(2)})}{2} \int_{\xi''}^{+\infty} \frac{[(\mathbf{a}^{(2)})^2 + s\boldsymbol{\varepsilon}_1]^{-1} ds}{\sqrt{\det((\mathbf{a}^{(2)})^2 + s\boldsymbol{\varepsilon}_1)}},$$

где $\mathbf{a}^{(1)}, \mathbf{a}^{(2)}$ — тензоры с главными компонентами, равными полуосям поверхностей S_1, S_2 , а главные оси совпадают с их осями соответственно.

Заключение

Основными результатами настоящей работы являются аналитические выражения для потенциала и напряженности электрического поля в анизотропных матрице, оболочке и ядре включения, представленные формулами (44) и (45) соответственно, выражение для тензора поляризуемости включения — формула (51). Также получены выражения для потенциала и напряженности поля в частном случае задачи, когда оболочка включения — изотропная (формулы (61), (62) и (58) соответственно).

Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при решении задач оценки эффективных характеристик неоднородных сред, например, поликристаллов с учетом межзеренного пространства и композитов с включениями вложенной структуры, а также для учета граничного слоя между включениями и матрицей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 16-08-00262-а и 17-08-01374-а).

Список литературы

- [1] *Stroud D.* // Phys. Rev. B. 1975. Vol. 12. N 8. P. 3368–3373.
- [2] *Фокин А.Г.* // УФН. 1996. Т. 166 № 10. С. 1069–1093. [*Fokin A.G.* // Phys. Usp. 1996. Vol. 39. P. 1009–1032.]
- [3] *Bruggeman D.A.G.* // Ann. Phys. 1935. Band 24. P. 636–664.
- [4] *Апресян Л.А., Власов Д.В., Задорин Д.А., Красовский В.И.* // ЖТФ. 2017. Т. 87. Вып. 1. С. 10–17. DOI: 10.21883/JTF.2017.01.44011.1841 [*Apresyan L.A., Vlasov D.V., Zadorin D.A., Krasovskii V.I.* // Tech. Phys. 2017. Vol. 62. N 1. P. 6–13.]
- [5] *Колесников В.И., Бардушкин В.В., Лавров И.В., Сычев А.П., Яковлев В.Б.* // ДАН. 2017. Т. 476. № 3. С. 280–284. DOI: 10.7868/S0869565217270081 [*Kolesnikov V.I., Bardushkin V.V., Lavrov I.V., Sychev A.P., Yakovlev V.B.* // Dokl. Phys. 2017. Vol. 62. N 9. P. 415–419.] DOI: 10.1134/S1028335817090087]
- [6] *Лавров И.В., Яковлев В.Б.* // ЖТФ. 2017. Т. 87. Вып. 7. С. 963–972. DOI: 10.21883/JTF.2017.07.44663.1964 [*Lavrov I.V., Yakovlev V.B.* // Tech. Phys. 2017. Vol. 62. N 7. P. 979–988.]
- [7] *Giordano S., Palla P.L.* // J. Phys. A: Math. Theor. 2008. Vol. 41. P. 415205. DOI:10.1088/1751-8113/41/41/415205
- [8] *Sihvola A.* Electromagnetic Mixing Formulas and Applications. The Institution of Electrical Engineers, London, 1999.
- [9] *Борен К., Хаффмен Д.* Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 1986. 660 с. [*Bohren C., Huffman D.R.* Absorption and Scattering of Light by Small Particles. Wiley, NY., 1983.]
- [10] *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Теоретическая физика. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1992. 664 с. [*Landau L.D., Lifshitz E.M.* Electrodynamics of Continuous Media. Butterworth–Heinemann, 1984.]
- [11] *Страттон Дж.* Теория электромагнетизма. М.-Л.: ГИТТЛ, 1948. 539 с. [*Stratton J.A.* Electromagnetic Theory. McGraw–Hill, 1941.]
- [12] *Апресян Л.А., Власов Д.В.* // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 12. С. 23–28. [*Apresyan L.A., Vlasov D.V.* // Tech. Phys. 2014. Vol. 59. N 12. P. 1760–1765.]
- [13] *Лерман Л.Б.* // Химия, физика и технология поверхности. 2008. Вып. 14. С. 91–100.
- [14] *Ораевский А.А., Ораевский А.Н.* // Квантовая электроника. 2002. Т. 32. № 1. С. 79–82. [*Oraevsky A.A., Oraevsky A.N.* // Quant. Electr. 2002. Vol. 32. N 1. P. 79–82.]
- [15] *Лавров И.В.* // Фундам. пробл. радиоэлектрон. приборостроения. 2013. Т. 13. № 1. С. 44–47.